

## Модули оптотиристорные и комбинированные\*

Представляют собой комбинации тиристоров оптронных (МТОТО), тиристора оптронного и диода (МТОД), диода и тиристора оптронного (МДТО). Представлены следующими типоисполнениями:

МТОТО4/3-40,

МТОД4/3-40,

МДТО4/3-40,

МТОТО4/3-63,

МТОД4/3-63,

МДТО4/3-63,

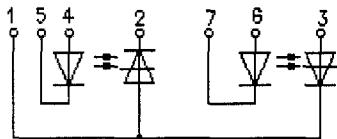
МТОТО4/3-80,

МТОД4/3-80,

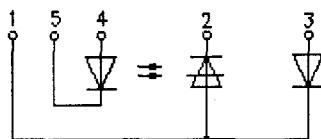
МДТО4/3-80.

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц. Применяются в устройствах, требующих гальванической развязки силовых и управляющих цепей.

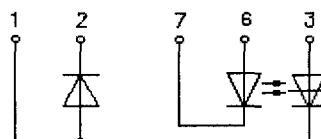
Схемы соединений элементов, соответствующие приведенным типоисполнениям модулей, показаны на рис. 2. 33.



a)



б)



в)

Рис. 2. 33. Схемы соединения полупроводниковых элементов модулей оптотиристорных и комбинированных :

а) МТОТО4/3-40, МТОТО4/3-63, МТОТО4/3-80,

б) МТОД4/3-40, МТОД4/3-63, МТОД4/3-80,

в) МДТО4/3-40, МДТО4/3-63, МДТО4/3-80.

Предельно допустимые значения параметров модулей приведены в табл. 2. 5, параметры и характеристики - табл. 2. 6, параметры и характеристики модулей с охладителями - табл. 2. 7, 2. 8.

Таблица 2. 5.

### Предельно допустимые значения параметров модулей оптотиристорных и комбинированных

Параметр		Значение параметра			Условия установления норм на параметры	
Обозна- чение	Наименование, единица измерения	Тип модуля				
		МТОТО4/3-40 МТОД4/3-40 МДТО4/3-40	МТОТО4/3-63 МТОД4/3-63 МДТО4/3-63	МТОТО4/3-80 МТОД4/3-80 МДТО4/3-80		
1	2	3	4	5	6	
U <sub>DRM</sub>	Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 4 5 6 7 8 9 10 11 12	400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200			T <sub>jm</sub> = 100 °C. Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный длительностью 10 мс, частота 50 Гц.	
U <sub>RRM</sub>						

\* см. изменение на стр. 5 pdf (стр. 42 каталога)

# МОДУЛИ ОПТОТИРИСТОРНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ

Продолжение табл. 2. 5

1	2	3	4	5	6
$U_{DSM}$	Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В		$1,12U_{DRM}$ $1,12U_{RRM}$		$T_{jm} = 100^{\circ}\text{C}$ . Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.
$U_{RSM}$					
$U_{DWM}$	Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В		$0,8U_{DRM}$ $0,8U_{RRM}$		$T_{jm} = 100^{\circ}\text{C}$ . Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.
$U_{RWM}$					
$U_D$	Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В		$0,6U_{DRM}$ $0,6U_{RRM}$		$T_c = 60^{\circ}\text{C}$ .
$U_R$					
$I_{T(AV)}$	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии и средний прямой ток, А	40	63	80	$T_c = 60^{\circ}\text{C}$ . Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.
$I_{F(AV)}$					
$I_{TRMS}$	Действующий ток в открытом состоянии и действующий прямой ток, А	63	100	125	$T_{jm} = 100^{\circ}\text{C}$ Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.
$I_{FRMS}$					
$I_{TSM}$	Ударный ток в открытом состоянии и ударный прямой ток, кА	1,37	1,60	1,65	$T_j = 25^{\circ}\text{C}; U_R = 0$ . Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, одиночный, длительностью 10 мс.
$I_{FSM}$					
$\left(\frac{di_T}{dt}\right)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс	1,25	1,45	1,50	$T_j = T_{jm}; U_R = 0$ . Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, одиночный, длительностью 10 мс.
			100		$T_{jm} = 100^{\circ}\text{C}; U_D = 0,67U_{DRM};$ $2I_{TAV} \leq I_{TM} \leq 5I_{TAV}$ . Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, частота 1 - 5 Гц. Режим цепи управления: форма - трапецидальная; длительность импульса тока 50 мкс; длительность фронта - 1 мкс; амплитуда импульса тока управления 250 мА; Внутреннее сопротивление источника управления 20 Ом.
$U_{isol}$	Электрическая прочность изоляции между беспотенциальным основанием модуля и его выводами, В, (действующее значение)		2000 (для 4-8 кл.) 2500 (для 9-12 кл.)		Напряжение синусоидальное, частота 50 Гц. Время выдержки под напряжением - 60 с . Выходы 1,2,3 закорочены между собой.

# МОДУЛИ ОПТОТИРИСТОРНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ

Продолжение табл.2.5

1	2	3	4	5	6
$U_{iG}$	Электрическая прочность изоляции между основными выводами и выводами управляющих электродов, В, (действующее значение)		2500		Напряжение синусоидальное, частота 50 Гц. Время выдержки под напряжением - 60 с. Выводы 1,2,3 модуля закорочены между собой. Управляющие выводы закорочены между собой.
$T_{jm}$	Температура перехода, °C: максимально допустимое значение;		100		
$T_{jmin}$	минимально допустимое значение		минус 40		
$T_{stgm}$	Температура хранения, °C: максимально допустимое значение		40 (для Y2), 50 (для T3)		
$T_{stgmin}$	минимально допустимое значение		минус 40		

Таблица 2. 6.

## Характеристики и параметры оптотиристорных и комбинированных модулей

Параметр		Значение параметра			Условия установления норм на параметры	
Обозна- чение	Наименование, единица измерения	Тип модуля				
		МТОТО4/3-40 МТОД4/3-40 МДТО4/3-40	МТОТО4/3-63 МТОД4/3-63 МДТО4/3-63	МТОТО4/3-80 МТОД4/3-80 МДТО4/3-80		
1	2	3	4	5	6	
$U_{TM}$	Импульсное напряжение в открытом состоянии и импульсное прямое напряжение, В, не более		1,75		$T_j = 25 \text{ } ^\circ\text{C}; I_{TM} = 3,14I_{T(AV)}$ $I_{FM} = 3,14I_{F(AV)}$ .	
$U_{FM}$						
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение в открытом состоянии и пороговое напряжение, В		1,1		$T_j = 100 \text{ } ^\circ\text{C}$ .	
$U_{TO}$						
$r_T$	Динамическое сопротивление, Ом	0,0052	0,0033	0,0026	$T_j = 100 \text{ } ^\circ\text{C}$ .	
$I_{DRM}$	Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии и повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более		6,0		$T_j = 100 \text{ } ^\circ\text{C}$ ; $U_D = U_{DRM}$ ; $U_D = U_{RRM}$ .	
$I_{RRM}$						
$I_L$	Ток включения, мА	70		100	$T_j = 25 \text{ } ^\circ\text{C}; U_D = 12 \text{ В}$ . Режим цепи управления: Форма импульса - трапецидальная : амплитуда -250 мА; длительность импульса -50 мкс ; длительность фронта - 1 мкс .	
$I_H$	Ток удержания, мА, не более	50		70	$T_j = 25 \text{ } ^\circ\text{C}; U_D = 12 \text{ В}$ . Цепь управления разомкнута.	



**Бичип**

**МОДУЛИ ОПТОТИРИСТОРНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ**

Продолжение табл. 2. 6

1	2	3	4	5	6
$\left( \frac{dU_D}{dt} \right)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, для групп: 0 1 2 3 4 5		.	Не нормируется 0 50 100 200 320	$T_j = 100 ^\circ C;$ $U_{DM} = 0,67 U_{DRM};$ $t u_D \geq 200 \text{ мкс.}$ Цепь управления разомкнута.
$t_{gd}$	Время задержки, мкс		7		$T_j = 25 ^\circ C; U_D = 100V.$ Режим цепи управления: Форма импульса - трапециoidalная ; амплитуда -250 mA; длительность импульса - 50 мкс; длительность фронта - 1 мкс .
$t_{gt}$	Время включения, мкс		15		$T_j = 25 ^\circ C; U_D = 100V.$ Режим цепи управления: Форма импульса - трапециoidalная ; амплитуда - 250 mA; длительность импульса - 50 мкс; длительность фронта - 1 мкс .
$t_q$	Время выключения, мкс, не более		100		$T_j = 100 ^\circ C; I_{TM} = I_{T(AV)};$ $\left( \frac{dI_T}{dt} \right)_f = 5A/\text{мкс};$ $t_i = 500 \text{ мкс}; U_R = 100 V;$ $U_{DM} = 0,67 U_{DRM};$ $t_u = 200 \text{ мкс};$ $\left( \frac{dU_d}{dt} \right)_{crit} = 50 \text{ В/мкс.}$
$Q_{rr}$	Заряд обратного восстановления, мКл	120	150	175	$T_j = 100 ^\circ C; I_{TM} = I_{T(AV)};$ $\left( \frac{dI_T}{dt} \right)_f = 5 A/\text{мкс};$
$t_{rr}$	Время обратного восстановления, мкс	8.0	9.0	10.0	$I_{FM} = I_{F(AV)};$ $\left( \frac{dI_F}{dt} \right)_f = 5 A/\text{мкс};$ $t_i = 500 \text{ мкс}; U_R = 100 V.$
$U_{GTM}$	Отпирающее импульсное напряжение управления, В, не более	2,0			$T_j = 25 ^\circ C; t_u = 100 \text{ мкс.}$
		3,0			$T_{jmin} = \text{минус } 40 ^\circ C;$ $t_u = 100 \text{ мкс.}$
$I_{GTM}$	Отпирающий импульсный ток управления, мА, не более	250			$T_j = 25 ^\circ C; t_u = 100 \text{ мкс.}$
		600			$T_{jmin} = \text{минус } 40 ^\circ C;$ $t_u = 100 \text{ мкс.}$
$U_{GD}$	Неотпирающее импульсное напряжение управления, В , не менее		0,90		$T_j = 100 ^\circ C; t_u = 100 \text{ мкс.}$
$U^*_{GT}$	Отпирающее постоянное напряжение управления , В, не более	1,6			$T_j = 25 ^\circ C.$
		1,8			$T_j = \text{минус } 40 ^\circ C.$



**Бичип**

# МОДУЛИ ОПТОТИРИСТОРНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ

Продолжение табл. 2. 6

1	2	3	4	5	6
$I_{GT}^*$	Отпирающий постоянный ток управления, мА, не более		80		$T_j = 25^\circ\text{C}$ .
$I_{GTmax}$	Максимально допустимый постоянный ток управления, мА		100		-
$I_{GTMmax}$	Максимально допустимый импульсный ток управления, мА		700		$t_u = 100 \mu\text{s}$ , скважность 10.
$R_{thje}$	Тепловое сопротивление переход - корпус, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	0,60	0,36	0,30	Постоянный ток.

Таблица 2. 7.

## Характеристики и параметры модулей с охладителем О127\*

Обозна- чение	Наименование, единица измерения	Значение параметра			Условия установления норм на параметры	
		Тип модуля				
		МТОТО4/3-40 МТОД4/3-40 МДТО4/3-40	МТОТО4/3-63 МТОД4/3-63 МДТО4/3-63	МТОТО4/3-80 МТОД4/3-80 МДТО4/3-80		
1	2	3	4	5	6	
$I_{T(AV)}$	Средний ток в открытом состоянии и средний прямой ток на элемент, А				Естественное охлаждение. $T_a = 40^\circ\text{C}$ . Ток синусоидальный, частота 50 Гц.	
$I_{F(AV)}$		30 21 13 9	38 25 14 10	41 27 15 11	В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов.	
$R_{thja}$	Тепловое сопротивление переход - среда одного элемента, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	1,50 2,30 3,90 5,50	1,26 2,06 3,66 5,26	1,20 2,00 3,60 5,20	В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов.	
$R_{thch}$	Тепловое сопротивление корпус - контактная поверхность охладителя, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$		0,1		Естественное охлаждение. Постоянный ток.	

\* Изменение в каталоге: всвязи со снятием с производства рекомендуемых охладителей заменить О127 на ОР344-120, О227 на ОР344-180 по ТУ У 32.1-30077685-015-2004 (Габаритные чертежи на [www.element.zp.ua](http://www.element.zp.ua) в Списке продукции/Охладители). При этом все тепловые расчеты и характеристики сохраняются.

# МОДУЛИ ОПТОТИРИСТОРНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ

## Характеристики и параметры модулей оптотиристорных и комбинированных с охладителем O227\*

Обозна- чение	Параметр Наименование, единица измерения	Значение параметра			Условия установления норм на параметры.	
		Тип модуля				
		МТОТО4/3-40	МТОТО4/3-63	МТОТО4/3-80		
		МТОД4/3-40	МТОД4/3-63	МТОД4/3-80		
		МДТО4/3-40	МДТО4/3-63	МДТО4/3-80		
		Тип охладителя				
		O227*				
1	2	3	4	5	6	
I <sub>T(AV)</sub>	Средний ток в открытом состоянии и средний прямой ток на элемент, А				Естественное охлаждение. $T_a = 40^{\circ}\text{C}$ . Ток синусоидальный, частота 50 Гц.	
I <sub>F(AV)</sub>		33 24 16 11	43 29 17 13	47 31 18 13	В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов.	
R <sub>thja</sub>	Тепловое сопротивление переход - среда одного элемента, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	1,36 2,02 3,34 4,66	1,12 1,78 3,10 4,42	1,06 1,72 3,04 4,36	В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов	
R <sub>thch</sub>	Тепловое сопротивление корпуса - контактная поверхность охладителя, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$		0,1		Естественное охлаждение. Постоянный ток.	

\*

\* см. изменение на стр. 5 pdf (стр. 42 каталога)